# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-257735

(43)Date of publication of application: 18.11.1991

(51)Int.CI.

H01J 1/26 1/14 H01J

(21)Application number: 02-056855

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

07.03.1990

(72)Inventor: SAITO MASATO

SUZUKI RYO

FUKUYAMA KEIJI OHIRA TAKUYA WATABE KEIJI

NAKANISHI TOSHIO

SANO KINJIRO

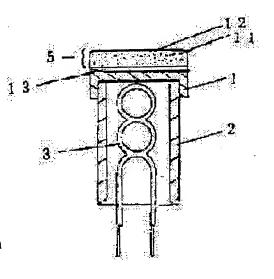
KAMATA TOYOICHI SHINJO TAKASHI

# (54) CATHODE FOR ELECTRON TUBE

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable actions under high current density which is equal to or more than 2A/cm2 by forming a specified metallic layer on a substrate, and thereby forming a specified electron emissive material layer so as to be adhered.

CONSTITUTION: The upper surface of a substrate 1 has a metallic layer 13, which is made of at least one kind of metal out of W, Mo, Ta, Cr, Si and the like. And the metallic layer 13 is covered with an electron emissive material layer 5 which is mainly composed of alkali earth metal oxide 11 containing, at least balium, besides strontium and/or calium, and of rare earth metal oxide containing 0.01 to 25% scandium oxide by weight, yttrium oxide and the like. By this constitution, life characteristics for actions under high current density which is equal to or more than 2A/cm2, is thereby remarkably enhanced.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

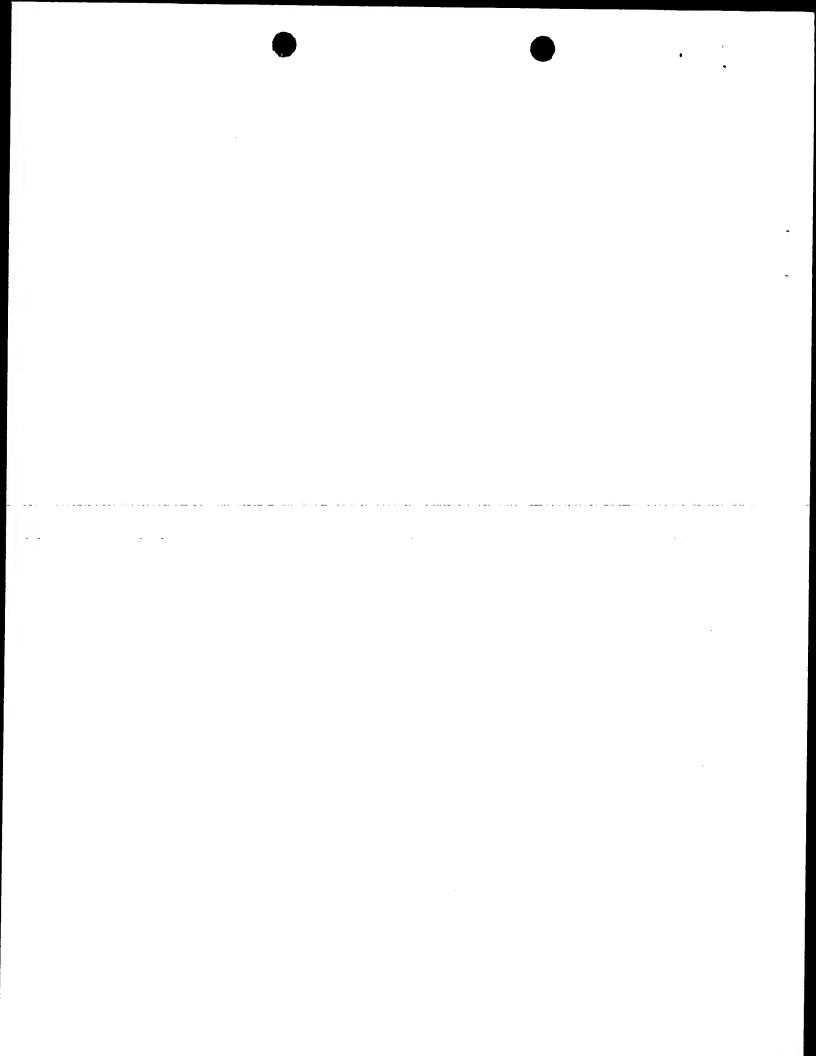
[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

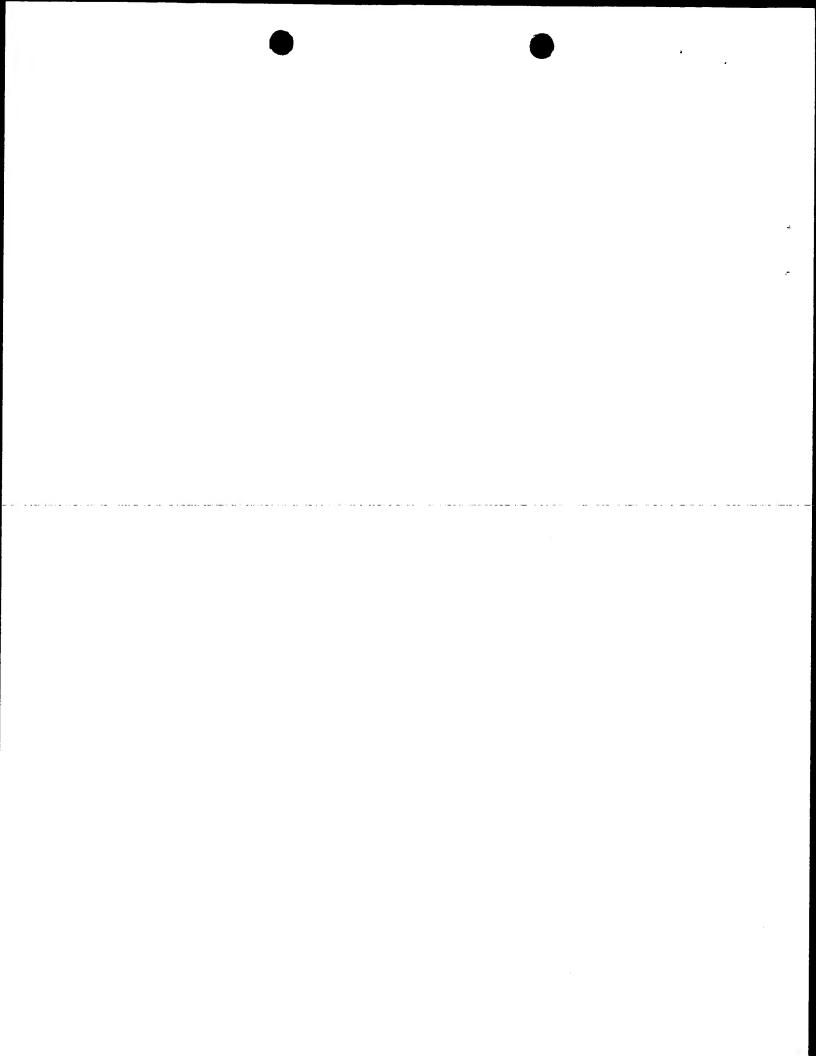


[Number of appeal against miner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office



⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

٠. 🚅

# ◎ 公開特許公報(A) 平3-257735

⑤Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月18日

H 01 J 1/26 1/14

B A 9058-5E 9058-5E

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

**公発明の名称** 電子管用陰極

②特 願 平2-56855

②出 願 平2(1990)3月7日

@発 明 者 斎 藤 正 人 神奈川県鎌倉市大船 2 丁目14番40号 三菱電機株式会社生

活システム研究所内

@発明者 鈴木 量 神奈川県鎌倉市大船2丁目14番40号 三菱電機株式会社生

活システム研究所内

@発明者福山 敬二神奈川県鎌倉市大船2丁目14番40号 三菱電機株式会社生

活システム研究所内

@発 明 者 大 平 卓 也 神奈川県鎌倉市大船 2 丁目14番40号 三菱電機株式会社生

活システム研究所内

勿出 願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

個代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

最終頁に続く

#### 明 無 書

# 1. 発明の名称

電子管用陰極

#### 2. 特許請求の範囲

- (2) 金属暦の厚みが2. 〇μm以下であること を特徴とする請求項1記載の電子管用陰極。
- (3)金属暦を形成した基体は真空中または遠元 雰囲気中で最高温度が800~1100℃で加熱 処理を施すことを特徴とする請求項1記載の電子 管用陰極。

## 3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明はテレビ用ブラウン管などに用いられる電子管用陰極の改良に関するものである。

[従来の技術]

次に、このように構成された電子管用陰極にお いて、基体(1)への電子放射物質層(5)の被 着方法について説明すると、まずパリウム、スト ロンチウム、カルシウムの三 元炭酸塩と所定量 の酸化スカンジウムをバインダー及び溶剤ととも に混合して、懸濁液 を作成する。この懸濁液を 基体(1)上にスプレイ法により約800μmの 厚みで塗布し、その後、ブラウン管の真空排気工 程中にヒータ(3)によって加熱する。この時、 アルカリ土類金属の炭酸塩はアルカリ土類金属酸 化物に変わる。その後、アルカリ土類金属酸化物 の一部を還元して半導体的性質を有するように活 性化を行なうことにより、基体 (1)上にアルカ リ土類金属酸化物(11)と希土類金属酸化物( - 12)との混合物からなる電子放射物質層(5) を被着せしめているものである。

この活性化工程において、アルカリ土類金属酸 化物の一部は次の様に反応しているものである。 つまり基体(1)中に含有されたシリコン、マグ

一般に酸化物陰種の電子放射能力は酸化物中の過 剰 B a の 存 在 量 に 依 存 す る の で 、 希 土 類 金 属 酸 化 物が含まれない場合には高電流動作に必要な十分 の過剰Baの供給が得られず、動作可能な電流密 度が小さい。すなわち、上記した反応時に生成さ れる副生成物であって中間層と呼ばれている酸化 マグネシウム (MgO) やバリウムシリケイト ( Ba \* Si O \* ) が基体(1) のニッケルの結晶 粒界や基体(1)と電子放射物質層(5)との界 面に集中的に形成されるため、上式(1)および (2)の反応がこれら中間層中のマグネシウムお よびシリコンの拡散速度に律速され、過剰Baの 供給が不足するためである。電子放射物質層中に 希土類金属酸化物が含まれる場合は、酸化スカン ジウム(ScょO。)を例にとり説明すると、陰 極動作時の基体(1)と電子放射物質層(5)と の界面では基体(1)中を拡散移動してきた還元 剤の一部と酸化スカンジウム(Sc.0.)が (3) 式の様に反応して少量の金属状のスカンジ ウムが生成され、金属状のスカンジウムの一部は

**朝金属酸化物(11)と基体(1)の界面に移動** して、アルカリ土類金属酸化物と反応する。例え ば、アルカリ土類金属酸化物として酸化パリウム (BaO) であれば次式(1)、(2)の様に反. 応するものである。

これらの反応の結果、基体(1)上に被着形成さ れたアルカリ土類金属酸化物(11)の一部 が退元されて、酸素欠乏型の半導体となり、電子 放射が容易になる。電子放射物質層に希土類金属 酸化物が含まれない場合で、陰種温度700~ 800℃の動作温度で0.5~0.8A/cdの ・電流密度動作が可能であり、電子放射物質層中に " 希土類金属酸化物が含まれた場合で、1.32~ ネシウム等の週元性元素は拡散によりアルカリ士 ----2: 6-4-A/cmの電流密度動作が可能になる。

> 基体 (1) のニッケル中に固溶し、一部は上記界 而に存在する。

$$1/2$$
 S c  $2$  O  $2$  +  $3/2$  M g = S c +  $3/2$  M g O --- (3)

(3) 式の様に反応して形成された金属状のスカ ンジウムは基体(1)上あるいは基体(1)のニ ッケルの粒界に形成された上記中間層を(4)式 の機に分解する作用を有するので、過剰Baの供 給が改善され、希土類金属酸化物が含まれない場 合よりも高電流密度動作が可能になると考えられ

また、特開昭 52-91358 号公報には機械的強度 を増大するW、Moなどの高融点金属とMg、 Al、Si、Zrなどの還元剤とを含有するNi

合金からなる基体上で、電子放射物質層が被着される面にNi-W、Ni-Moなどの合金層をコーティングする直熱型の陰種技術が開示されている。

## [発明が解決しようとする課題]

この様に構成された電子管用陰極においては、 希土類金属酸化物が過剰 B a の供給を改善するものの、過剰 B a の供給速度は基体のニッケル中の 還元剤の拡散速度に律速され、2 A / c m 以上の 高電流密度動作での寿命特性は著しく低くなるという課題を有していた。

また、後者に示したものにおいては、基体自身に電流を流しその発熱を利用して電子放射物質層から熱電子を放射させる直熱型陰極固有の問題点である基体の熱変形を、NiーW、NiーMoなどの合金層を基体上にコーティングすることにより、改善するものであり、高電流密度動作を可能にすることができなかった。

## [課題を解決するための手段]

この発明に係る電子管用陰極は、少なくとも一

の金属暦(13)上に被着され、少なくともバリウムを含み、他にストロンチウムあるいは/およびカルシウムを含むアルカリ土類金属酸化物(11)を主成分とし、0.0i~25重量%の酸化スカンジウム、酸化イットリウムなどの希土類金属酸化物を含む電子放射物質層である。

 種の退元剤を含有してなる基体上にこの現元剤の 少なくとも一種より退元性が大きい、金属を 分とする金属層を形成するとともに、この金属層を 上に少なくともが、この1~25 酸化物を主成分とし、0.01~25 量%のの成 生物を主成分とし、25 量%のが成 生たものである。

#### [作用]

この発明においては、 基体中の 選元 別に加え、 基体上に形成された金属層が過剰 B a の 供給に寄 与するとともに、 界面でこの金属層が安定して中 間層の分解効果を有する希土類金属の生成にも寄 与するので、 特に 2A / c m 以上の高電流密度動 作での寿命特性 が著しく向上するものである。 [発明の実施例]

以下にこの発明の一実施例を第 1 図に基づいて 説明する。図において、(1 3 )は基体( 1 )の 上面に形成された例えばW、Mo、Ta、Cr、 Siなどの少なくとも一種の金属層、(5)はこ

部上に従来と同様に電子放射物質層(5)を被着 形成するものである。第3図はこの様な方法で作 成した本発明を実施してなる電子管用陰極を通常 のテレビジョン装置用ブラウン管に装着し、通常 の排気工程をへて完成したブラウン管を電流密度 2 A/cmの条件で動作させた時の寿命特性を、 従来例と比較して示したものである。ここで、金 腐屑 ( 1 3) としては膜厚 0 . 2μm の W 膜を形 成し、水素雰囲気中で1000℃で加熱処理を施 した。なお、電子放射物質層(5)としては、比 較のため実施例および従来例ともに、7重鼠%の 酸化スカンジウムを含むアルカリ土類金属酸化物 (11) を用いた。この第3図から明らかなよう に、本実施例のものは従来例のものに比べ寿命中 のエミッション劣化が著しく少ないものである♪ この様に、この発明を実施してなる電子管用陰 便の優れた特性の原因は以下の様に考えられる。 即ち、この発明の金属層(13)は腹厚の薄い層

として形成されているので、動作時において金属

層 (13) は 薪体 (1) の N i の 結晶 粒上 に の み

分布し、この N i の結晶粒界は基体(1)上面で電子放射物質層(5)側に露出しているので、基体(1)中の選「元剤は金属層(1 3)の影響を受けず前述の反応式(1)、(2)に基づき過剰Baを供給する。それに加えて、金属層(1 3)であるWは次式(5)の様に、電子放射物質層(5)の還元による過剰Baの供給にも寄与する。

2 B a O + 1 / 3 W = B a + 1 / 3 B a , W O . --- (5)

さらに、Wは基体(1)中の還元剤であるSi、Mgよりも還元性が小さいが、基体(1)のNi粒子上に分布しているので、電子放射物質層(5)内の酸化スカンジウムとの反応が比較的容易に起こり、中間層分解の効果を有するScの生成にも寄与する。

金属層(13)がWである場合を例にとり説明 したが、金属層(13)は基体(1)中の退元剤 の少なくとも一つの退元剤よりも退元性が同等ま

い。これは、金属層(13)の厚みが2.0μm以上では基体(1)中の遠元元素の電子放射物質層(5)への拡散がこの金属層(13)によって 律速され、遠元元素によるBa供給が不足するためである。

金属層の形成した基体は真空中または還元雰囲気中で最高温度が800~1100℃で加熱処理を施すことが望ましい。この加熱処理により、金属層(13)を主に基体(1)のNi粒子上に分布するように制御することが可能になり、基体(1)中の還元元素の電子放射物質層(5)への拡散が適正に維持できる。

この発明を実施してなる電子管用陰極はテレビ用ブラウン管や撮像管に適用可能であるが、投射型テレビなどのブラウン管に適用して高電流で動作することにより、高輝度化が実現できる。特にイビジョンテレビ用ブラウン管の高輝度化に有効である。また、ディスプレンを1000である。また、ディスプレンである。また、ディスプレン・1000である。また、ディスプレン・1000である。また、ディスプレン・1000である。また、ディスプレン・1000である。また、ディスプレン・1000である。また、ディスプレン・1000である。また、ディスプレン・1000である。また、ディスプレン・1000である。また、ディスプレン・1000である。また、ディスプレン・1000である。また、ディスプレン・1000である。また、ディスプレン・1000である。

たは小さく、Niより返元性が大きいことが望ましい。その理由は、金属層(13)の返元性がNiより小さいと過剰Baの供給効果が少なく、

落体(1)中の遠元剤の返元性より大きいと過剰
Baの主たる供給反応は金属層(13)と電子放射物質層(5)との界面で起こり、基体(1)中の遠元剤の過剰Ba供給効果が小さくなり、上述した酸化スカンジウムの中間層分解効果の特性への寄与が小さくなるからである。

上記金属層(13)としては基体(1)中の選元別の構成に依存するが、W、Mo、Ta、Cr、Si、Mgなどの少なくとも一種の金属を選択すれば良い。 また、上記金属層 (13)は基体(1)中の還元剤の少なくとも一つの還元剤はりも還元性が同等または小さくNiより還元性が大きい金属に、Niの還元性以下の金属、例えばNiを加えた合金層で構成しても良い。

また、上記金属層(13)の厚みが2.0μm 以下であることが望ましく、特に0.8μm以下 であると高電流密度動作での寿命特性向上が著し

用することにより、従来よりも高精細のブラウン 管が実現できる。

#### [発明の効果]

#### 4. 図面の簡単な説明

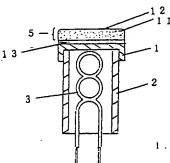
第1図はこの発明の一実施例を示す断面図、第 2図はこの発明を実施してなる電子管用陰極を装 着したブラウン管の寿命試験時間とエミッション 電流比を示す特性図、第3図は従来の電子管用陰 極の構造を示す断面図である。

図において、(1) は基体、(5) は電子放射 物質層、(13) は金属層である。

なお、各図中同一符合は同一または相当部分を 示す。

代理人 大岩 增雄

15E 1 17



基体

. スリーブ

3. ヒーク

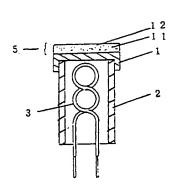
5. 電子放射物質層

13.金属層

第 2 図

| 100 | 実施例 | 従来例 | 従来例 | 20 | 2000 | 4000 | 動作時間 (時間)

第 3 図



1. 基体

.2. スリーブ

3. ヒータ

5. 電子放射物質層

第1頁の続き		
⑩発 明 者 渡 部	勁 二	神奈川県鎌倉市大船2丁目14番40号 三菱電機株式会社生
		活システム研究所内
⑩発 明 者 中 西	寿 夫	京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機株式会社京都製
		作所内
⑩発 明 者 佐野	金 治 郎	京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機株式会社京都製
		作所内
⑩発明者 鎌田	豊一	京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機株式会社京都製
		作所内
@発明者 新庄	孝	京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機株式会社京都製
_		作所内